【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成31年3月14日(2019.3.14)

【公開番号】特開2018-60933(P2018-60933A)
【公開日】平成30年4月12日(2018.4.12)
【年通号数】公開・登録公報2018-014
【出願番号】特願2016-198125(P2016-198125)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/822　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/04　(2006.01)
Ｈ０３Ｆ　1/30　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/065　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/07　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/18　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/04　Ｈ
Ｈ０３Ｆ　1/30
Ｈ０１Ｌ　27/04　Ｒ
Ｈ０１Ｌ　27/04　Ｅ
Ｈ０１Ｌ　25/08　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月29日(2019.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る半導体装置の断面図である。
【図２】実施の形態１に係る第１基板の平面図である。
【図３】比較例に係る半導体装置の断面図である。
【図４】シリコンの導電率の温度特性を示す図である。
【図５】実施の形態１の第１の変形例に係る第２基板の平面図である。
【図６】実施の形態１の第１の変形例に係る第２基板の底面図である。
【図７】実施の形態１の第２の変形例に係る半導体装置の断面図である。
【図８】比較例に係る半導体装置の断面図である。
【図９】実施の形態２に係る半導体装置の断面図である。
【図１０】実施の形態３に係る半導体装置の断面図である。
【図１１】実施の形態４に係る半導体装置の断面図である。
【図１２】実施の形態４の第１の変形例に係る半導体装置の断面図である。
【図１３】実施の形態４の第２の変形例に係る半導体装置の断面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
図７は、実施の形態１の第２の変形例に係る半導体装置の断面図である。第２の変形例

に係る半導体装置２８０において、第１基板１０と第２基板２０は、樹脂２６０で封止されている。その他の構造は、半導体装置８０と同様である。第１基板１０と第２基板２０が樹脂２６０で封止されることで、衝撃および高湿度の大気から半導体装置２８０を保護できる。樹脂２６０はエポキシ樹脂である。